



(PR情報)

各 位

平成27年3月5日

会 社 名 株式会社ブイ・テクノロジー
代 表 者 代表取締役社長 杉本 重人
(コード番号：7717 東証1部)
問 合 せ 先 企画部 IR グループ長 吉村省吾
(TEL：045-338-1980)

独立行政法人科学技術振興機構「産学共同実用化開発事業」

開発課題「大型フラットパネルディスプレイ向けレーザアニール技術」採択に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：横浜市保土ヶ谷区、以下「当社」）は、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」）の産学共同実用化開発事業（以下「NextTEP」）*の第四回募集に応募しておりましたが、平成27年3月1日付けで開発課題「大型フラットパネルディスプレイ向けレーザアニール技術」として正式に採択されましたのでお知らせいたします。

開発課題「大型フラットパネルディスプレイ向けレーザアニール技術」は、国立大学法人 山形大学 大学院理工学研究科 城戸淳二教授のレーザアニール処理**に関するシーズ特許を利用した新しい大型・高精細フラットパネルディスプレイ向けのレーザアニール技術であり、レーザアニール処理効率を飛躍的に向上し、その処理速度を向上、かつ処理にかかわるランニングコストをも低減可能にする技術です。平成27年3月1日より本開発を開始し、次世代大型・高精細フラットパネルディスプレイ製造に貢献できる製造装置としての実用化を目指します。

* 産学共同実用化開発事業について

NextTEPは、大学などの研究成果に基づくシーズを用いた、企業単独では困難な開発を支援し実用化を目指す、産学連携プロジェクト支援事業です。

** レーザアニール処理とは

フラットパネルディスプレイ（FPD）はガラス基板上に薄膜トランジスタ（TFT）を低温で形成しなければならないため、低温処理プロセスが必須となっています。一方で、次世代のディスプレイの大型化や高精細化には電子移動度の高いポリシリコン半導体膜が必要です。

このような低温ポリシリコン（LTPS）プロセスにおいてポリシリコン半導体膜を形成するには、低温処理プロセスで成膜されたアモルファスシリコン半導体膜に紫外線パルスレーザ光を照射し、ガラス基板の温度を上げずに瞬間的にアモルファスシリコン半導体膜のみ熔融、再結晶化（ポリシリコン化）させるレーザアニール処理が使われています。

以上